

SZX 21/1; 5,1 ... 24



Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastikgehäuse. Sie dienen zur Spannungsstabilisierung und -begrenzung sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

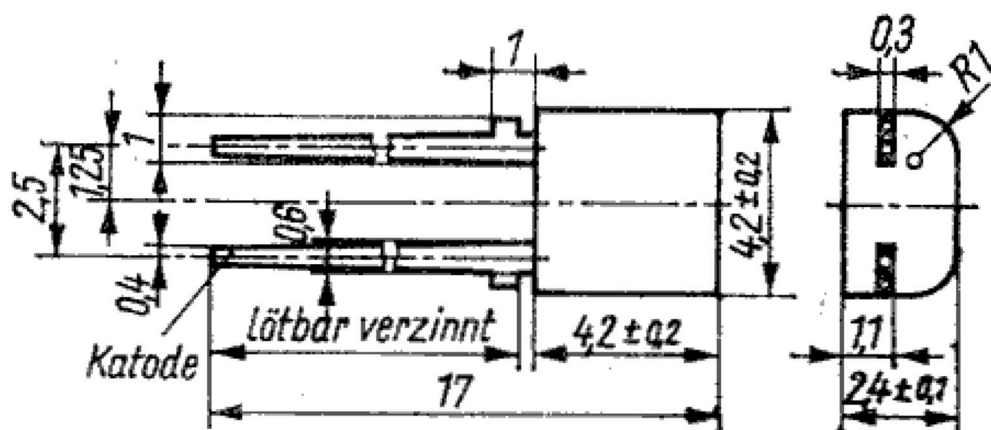
Die Z-Dioden SZX 21 werden in der E 24-Reihe (5%) geliefert.

Grenzwerte

Gesamtverlustleistung	P_{tot}	400 mW ¹⁾
	P_{tot}	250 mW ²⁾
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	150 °C
Wärmewiderstand	R_{th}	0,31 K/mW ¹⁾
	R_{th}	0,5 K/mW ²⁾
Lagerungstemperaturbereich	ϑ_{stg}	-50 ... +50 °C
Betriebstemperaturbereich	ϑ_o	-55 ... +100 °C

1) Angaben gelten, wenn Anschlußdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf einer Temperatur von $\vartheta_o = 25$ °C gehalten werden

2) ohne zusätzliche Kühlung



Kennwerte bei $\vartheta_o = 25$ °C

Typ	Z-Spannung U_z/V	Z-Widerstand r_z/Ω	Sperrspannung U_R/V	rel. Temperaturkoeff. der Z-Spannung $TK_{uz}/\%/K$
		bei $I_z = 5$ mA	bei $I_R = 1$ μ A	
SZX 21/1 ¹⁾	0,73 ... 0,83	≤ 8	-	-0,22 ... -0,18
SZX 21/5,1	4,8 ... 5,4	≤ 60	$\geq 0,8$	-0,05 ... +0,03

SZX 21/1 ¹⁾	0,73 ... 0,83
SZX 21/5,1	4,8 ... 5,4
SZX 21/5,6	5,2 ... 6,0
SZX 21/6,2	5,8 ... 6,6
SZX 21/6,8	6,4 ... 7,2
SZX 21/7,5	7,0 ... 7,9
SZX 21/8,2	7,7 ... 8,7
SZX 21/9,1	8,5 ... 9,6
SZX 21/10	9,4 ... 10,6
SZX 21/11	10,4 ... 11,6
SZX 21/12	11,4 ... 12,8
SZX 21/13	12,6 ... 14,0
SZX 21/15	13,8 ... 15,5
SZX 21/16	15,3 ... 17,0
SZX 21/18	16,8 ... 19,0
SZX 21/20	18,8 ... 21,0
SZX 21/22	20,8 ... 23,0
SZX 21/24	22,8 ... 25,6

Durchlaßspannung bei $I_F = 50 \text{ mA}$, $U_F \leq 1 \text{ V}$

VII	8
VIII	60
IX	40
X	10
XI	8
XII	7
XIII	7
XIV	10
XV	10
XVI	15
XVII	20
XVIII	20
XIX	25
XX	30
XXI	40
XXII	55
XXIII	55
XXIV	55
XXV	80

-	- 0,22 ... - 0,18
0,8	- 0,05 ... + 0,03
1	- 0,02 ... + 0,05
1	- 0,01 ... + 0,06
2	- 0,00 ... + 0,07
2	+ 0,02 ... + 0,07
3,5	+ 0,03 ... + 0,07
3,5	+ 0,04 ... + 0,08
5	+ 0,05 ... + 0,08
5	+ 0,05 ... + 0,08
7	+ 0,06 ... + 0,09
7	+ 0,065 ... + 0,09
10	+ 0,07 ... + 0,09
10	+ 0,07 ... + 0,09
10	+ 0,07 ... + 0,09
10	+ 0,07 ... + 0,09
12	+ 0,07 ... + 0,09
12	+ 0,075 ... + 0,095

¹⁾ wird in Durchlaßrichtung betrieben